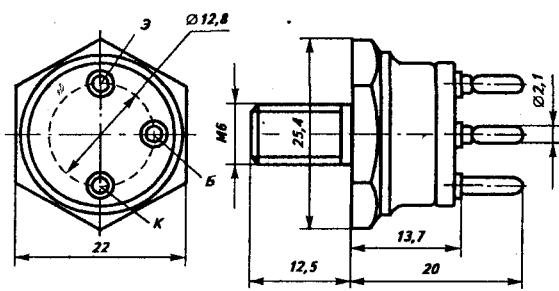


□ KT879A, KT879B

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n переключаемые. Предназначены для применения в мощных переключающих устройствах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами с винтом для крепления, тип корпуса КТ-5. Масса транзистора не более 28 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ транзистора KT879A при $U_{кз} = 4$ В, $I_k = 20$ А и транзистора KT879B при

$U_{кз} = 5$ В, $I_k = 15$ А, не менее:
 при $T = +25^\circ\text{C}$ и $T_k = +125^\circ\text{C}$ 10
 при $T = -60^\circ\text{C}$ 7

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 1$ А, $T = +25^\circ\text{C}$, не менее 10 МГц

Граничное напряжение при $I_k = 0,1$ А, не менее:
 KT879A 150 В
 KT879B 100 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_k = 20$ А, не более:
 KT879A при $I_б = 2$ А 2 В
 KT879B при $I_б = 5$ А 2,5 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_k = 20$ А, не более:
 KT879A при $I_б = 2$ А 1,8 В
 KT879B при $I_б = 5$ А 2 В

Энергия вторичного пробоя при $U_{бз} = -1$ В, $R_{бз} = 50$ Ом, $L = 10$ мГн, не менее 100 мДж

Время включения при $I_k = 20$ А, не более:
 KT879A при $U_{кз} = 100$ В, $I_б = 2$ А 0,5 мкс
 KT879B при $U_{кз} = 50$ В, $I_б = 5$ А 1,0 мкс

Время рассасывания при $I_k = 20$ А, не более:
 KT879A при $U_{кз} = 100$ В, $I_б = 2$ А 1,5 мкс
 KT879B при $U_{кз} = 50$ В, $I_б = 5$ А 2 мкс

Время спада при $I_k = 20$ А, не более:
 KT879A при $U_{кз} = 100$ В, $I_б = 2$ А 0,5 мкс
 KT879B при $U_{кз} = 50$ В, $I_б = 5$ А 2 мкс

Обратный ток коллектора, не более:
 при $T = +25^\circ\text{C}$:
 KT879A при $U_{кб} = 200$ В 3 мА
 KT879B при $U_{кб} = 150$ В 3 мА
 при $T = -60^\circ\text{C}$ и $T_k = +125^\circ\text{C}$:

KT879A при $U_{кб} = 200$ В 10 мА
 KT879B при $U_{кб} = 150$ В 10 мА

Обратный ток эмиттера при $T = +25^\circ\text{C}$, не более:
 KT879A при $U_{бз} = 6$ В 10 мА
 KT879B при $U_{бз} = 5$ В 25 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база
 KT879A 200 В
 KT879B 150 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бз} = 100$ Ом:
 KT879A 200 В
 KT879B 150 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бз} < 100$ Ом, $t_f > 1$ мкс
 KT879A 200 В
 KT879B 150 В

Постоянное напряжение эмиттер-база 6 В

Постоянный ток коллектора 50 А

Импульсный ток коллектора 75 А

Постоянный ток базы 20 А

Импульсный ток базы 30 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при $U_{кз} = 20$ В, $T_k = +25^\circ\text{C}$ 250 Вт

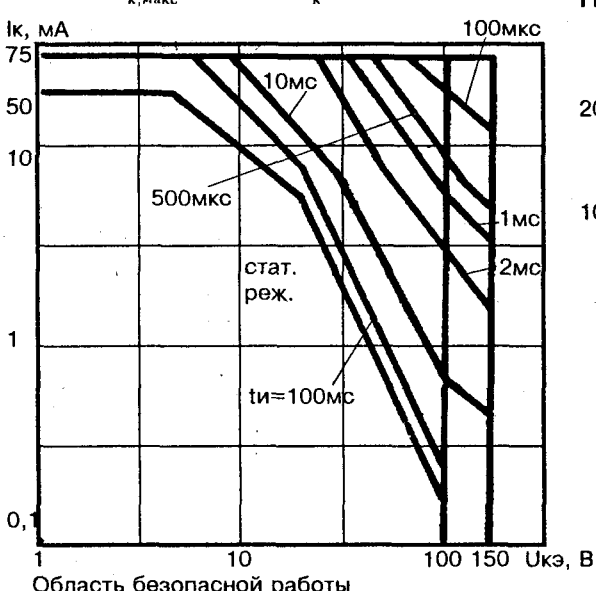
Температура p-n перехода $+200^\circ\text{C}$

Температура окружающей среды $-60^\circ\text{C} \dots T_k = +125^\circ\text{C}$

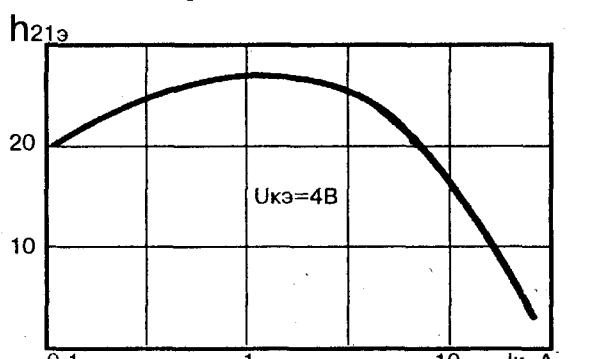
¹При $T_k = +25 \dots +125^\circ\text{C}$ и напряжении коллектор-эмиттер 5...20 В постоянная

рассеиваемая мощность коллектора определяется из выражения

$$P_{к, макс} = (200 - T_k) / 0,7, \text{ Вт}$$



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока базы



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора $U_{кзнас}, \text{ В}$

